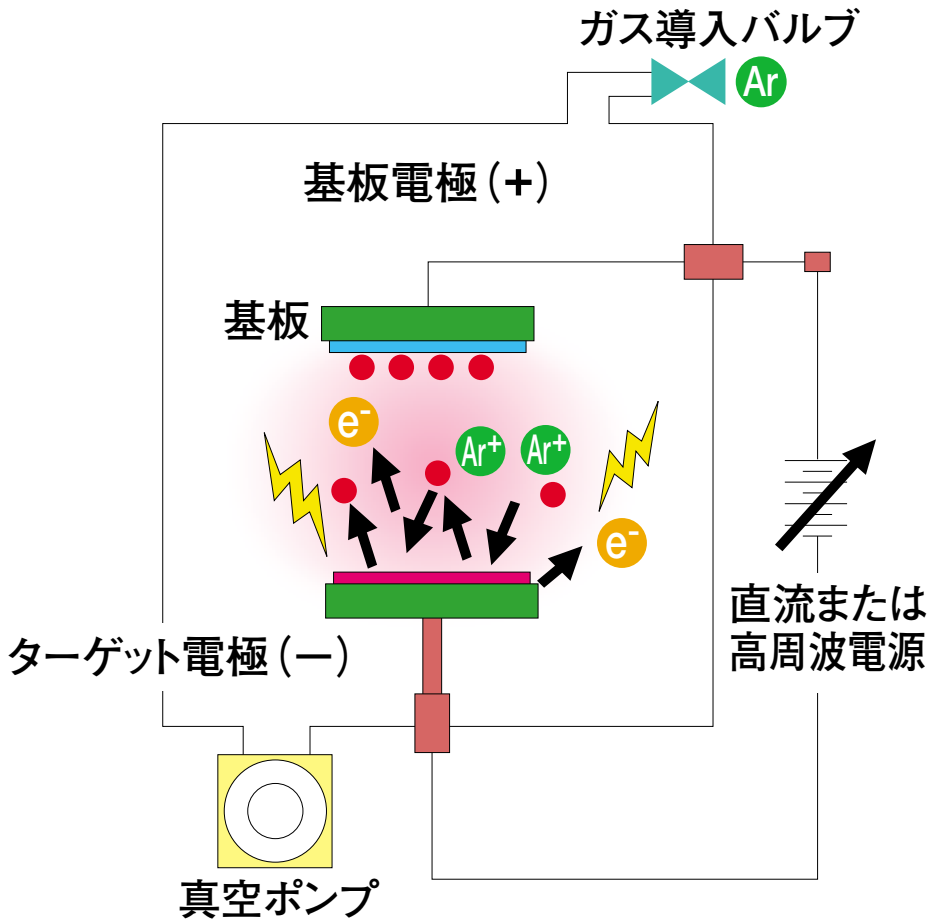


# 薄膜の作製法

## ③スパッタリング



基板とターゲットを対向させておき、数Pa～数10Pa程度のArガス雰囲気中でターゲットに数kVの負の高電圧を印加し、放電させるとArガスは正イオンとなってターゲットに衝突し、ターゲットの原子を叩き出します（スパッタまたはスパッタリング現象）。原子は基板の上に堆積し薄膜を形成します。この薄膜形成方法をスパッタ法またはスパッタリング法と呼びます。

現在では、ターゲット背面に磁石を置いて成膜速度を向上させたマグネトロン・スパッタリング法が産業界で利用されています。